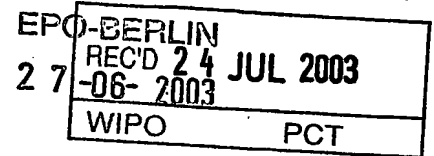


PCT/EP03/04215  
**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

Best Available Copy

**Aktenzeichen:** 102 18 799.1

**Anmeldetag:** 23. April 2002

**Anmelder/Inhaber:** IHP GmbH Innovations for High Performance Micro-  
electronics/Institut für innovative Mikroelektronik,  
Frankfurt, Oder/DE

**Bezeichnung:** Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als Dielek-  
trikum

**IPC:** H 01 L 21/822

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. Juni 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

H018

**München**  
Patentanwälte  
European Patent Attorneys  
Dipl.-Phys. Heinz Nöth  
Dipl.-Wirt.-Ing. Rainer Fritsche  
Lbm.-Chem. Gabriele Leißler-Gerstl  
Dipl.-Ing. Olaf Ungerer  
Patentanwalt  
Dipl.-Chem. Dr. Peter Schuler

**Alicante**  
European Trademark Attorney  
Dipl.-Ing. Jürgen Klinghardt

**Berlin**  
Patentanwälte  
European Patent Attorneys  
Dipl.-Ing. Henning Christiansen  
Dipl.-Ing. Joachim von Oppen  
Dipl.-Ing. Jutta Kaden  
Patentanwalt  
Dipl.-Phys. Dr. Andreas Theobald

**Pacelliallee 43/45**  
**D-14195 Berlin**  
**Tel. +49-(0)30-841 8870**  
**Fax +49-(0)30-8418 8777**  
**Fax +49-(0)30-832 7064**  
**mail@eisenfuhr.com**  
**http://www.eisenfuhr.com**

**Bremen**  
Patentanwälte  
European Patent Attorneys  
Dipl.-Ing. Günther Eisenführ  
Dipl.-Ing. Dieter K. Speiser  
Dr.-Ing. Werner W. Rabus  
Dipl.-Ing. Jürgen Brügge  
Dipl.-Ing. Jürgen Klinghardt  
Dipl.-Ing. Klaus G. Göken  
Jochen Ehlers  
Dipl.-Ing. Mark Andres  
Dipl.-Chem. Dr. Uwe Stilkenböhmer  
Dipl.-Ing. Stephan Keck  
Dipl.-Ing. Johannes M. B. Wasilijeff

**Rechtsanwälte**  
Ulrich H. Sander  
Christian Spintig  
Sabine Richter  
Harald A. Förster

**Hamburg**  
Patentanwalt  
European Patent Attorney  
Dipl.-Phys. Frank Meier

**Rechtsanwälte**  
Rainer Böhm  
Nicol A. Schrömgens, LL.M.

Berlin, 22. April 2002

Unser Zeichen: IB1194 JVO/THE/kli  
Durchwahl: 030/841 887 0

Anmelder/Inhaber: IHP GMBH  
Amtsaktenzeichen: Neuanmeldung

**IHP GMBH – Innovations for High Performance Microelectronics /**  
**Institut für innovative Mikroelektronik,**  
**Im Technologiepark 25, D-15236 Frankfurt (Oder)**  
**Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als Dielektrikum**

Die Erfindung betrifft einen Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als Dielektrikum sowie ein Verfahren zum Herstellen einer dünnen Oxynitridschicht auf Silizium.

Halbleiterkondensatoren sind aus der modernen Halbleitertechnologie nicht mehr wegzudenken. Wichtige Anwendungsbeispiele für Halbleiterkondensatoren sind dynamische Direktzugriffsspeicher (DRAM), in denen die Halbleiterkondensatoren als Speicherzellen Verwendung finden, und Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs, metal-oxide semi-conductor field-effect transistor), in denen das Substrat, die Gateelektrode und das zwischen Substrat und Gateelektrode liegende Gateoxid einen Halbleiterkondensator bilden.

Für einen Halbleiterkondensator gilt wie für alle Kondensatoren, dass die Kapazität des Kondensators proportional zur Dielektrizitätszahl des zwischen den Kondensatorelektroden befindlichen Dielektrikums und der Fläche der Kondensatorelektroden sowie zum Reziprokenwert des Abstandes zwischen den Kondensatorelektroden, also der Dicke des Dielektrikums, ist. Als Dielektrikum wird in der Halbleitertechnik häufig Siliziumoxid ( $\text{SiO}_2$ ) eingesetzt.

Mit der zunehmenden Verringerung der Bausteingröße in der Halbleitertechnik werden auch die Abmessungen der Kondensatorplatten von Halbleiterkondensatoren, beispielsweise der Gateelektroden von MOSFETs, immer kleiner. Damit verringert sich aber auch die Kapazität des Halbleiterkondensators, sofern keine Maßnahmen ergriffen werden, dem entgegenzuwirken.

Zum Kompensieren der Verringerung der Abmessungen der Kondensatorelektroden gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, die Dicke des Dielektrikums zu verringern. Dies führt beispielsweise in MOSFETs, in denen als Dielektrikum typischerweise Siliziumoxid Verwendung findet, bei Gatelängen von weniger als  $0,1 \mu\text{m}$  zu Problemen. Das Siliziumoxid für Bauelemente mit derart geringen Gatelängen müsste dann dünner als  $1,5 \text{ nm}$  sein. Ein solch dünnes Siliziumoxid führt jedoch zu einer Zunahme des Leckstroms des MOSFETs. Der Leckstrom entsteht aufgrund von Elektronen, die durch das dünne Gateoxid zwischen dem Substrat und der Gateelektrode tunneln. Die Zahl der tunnelnden Elektronen und damit die Stromstärke des Leckstroms wächst exponentiell mit geringer werdender Dicke der Siliziumoxidschicht. Es ist jedoch erwünscht, den Leckstrom eines MOSFETs möglichst gering zu halten, da zum Steuern des Stromes zwischen der Drainelektrode und der Sourceelektrode möglichst wenig elektrische Leistung verbraucht werden soll.

Die zweite Möglichkeit, die Verringerung der Kondensatorelektrodenfläche zu kompensieren, besteht darin, nicht die Dicke des Dielektrikums sondern dessen Dielektrizitätszahl zu ändern. Wird beispielsweise statt Siliziumoxid Praseodymoxid ( $\text{Pr}_2\text{O}_3$ ) als Dielektrikum verwendet, so lässt sich aufgrund

der gegenüber Siliziumoxid höheren Dielektrizitätszahl des Praseodymoxids die Kapazität des Kondensators bei ansonsten gleichen Parametern deutlich erhöhen. Siliziumoxid besitzt eine Dielektrizitätszahl von 3,9, wohingegen Praseodymoxid eine Dielektrizitätszahl von 30 besitzt. Dies bedeutet, dass mit Praseodymoxid als Dielektrikum das Gateoxid um den Faktor 30 dividiert durch 3,9 dicker sein kann als ein Dielektrikum aus Siliziumoxid. Mit Praseodymoxid als Gatedielektrikum lässt sich daher der Leckstrom gegenüber Siliziumoxid als Dielektrikum drastisch verringern.

Die Dicke einer Siliziumoxidschicht, die bei konstanter Fläche der Kondensatorelektroden dieselbe Kapazität liefert wie die Praseodymoxidschicht wird im Folgenden als äquivalente Oxidschichtdicke bezeichnet. Mit zunehmender Verringerung der Bausteingröße muss diese äquivalente Oxidschichtdicke kleiner werden, um die Verringerung der Kondensatorelektrodenfläche zu kompensieren. Mittels Praseodymoxid als Dielektrikum lässt sich die tatsächliche Oxidschichtdicke gegenüber der äquivalenten Oxidschichtdicke vergrößern, und somit der tunnelnde Leckstrom verringern.

Praseodymoxid wird typischerweise durch Verdampfen von  $\text{Pr}_6\text{O}_{11}$  auf Silizium deponiert. Dabei bildet sich zwischen dem Silizium und dem Praseodymoxid ( $\text{Pr}_2\text{O}_3$ ) ein Mischoxid der Form  $(\text{PrO}_2)_x(\text{SiO}_2)_{1-x}$  mit  $0 < x < 1$ , typischerweise in nicht stöchiometrischer Form. Auf das Abscheiden folgende thermische Prozessschritte führen darüber hinaus zu einer weiteren Ausbreitung des Mischoxids, insbesondere des  $\text{SiO}_2$ -Anteils.

Das Mischoxid besitzt eine geringere Dielektrizitätszahl als das reine Praseodymoxid, wodurch die äquivalente Oxidschichtdicke des Dielektrikums gegenüber einem reinen Praseodymoxid dielektrikum vergrößert wird. Das Mischoxid verschlechtert daher die elektrischen Eigenschaften des Dielektrikums und damit des Halbleiterkondensators, und zwar um so mehr, je dicker das Mischoxid ist.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Halbleiterkondensator mit Praseodymoxid als Dielektrikum derart weiterzubilden, dass er verbesserte elektrische Eigenschaften aufweist.

Diese Aufgabe wird durch einen Halbleiterkondensator nach Anspruch 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche enthalten weitere Ausgestaltungen und Merkmale der vorliegenden Erfindung.

Gemäß Anspruch 1 wird zum Lösen der oben genannten Aufgabe ein Halbleiterkondensator mit einer ersten Kondensatorelektrode bildenden, Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht, einer zweiten Kondensatorelektrode und einem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum zwischen den Kondensatorelektroden bereitgestellt, in dem zwischen dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum und mindestens der Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht eine erste dünne Zwischenschicht vorhanden ist, die eine Diffusionsbarriere für Sauerstoff darstellt.

Als Schicht soll hierbei nicht nur ein parallel zur Oberfläche eines Halbleitersubstrats verlaufender Materialbereich verstanden werden. Eine Schicht im Sinne der Erfindung kann auch senkrecht oder in beliebigen anderen Winkeln zur Substratoberfläche verlaufen. Insbesondere kann der Halbleiterkondensator als vertikaler oder als lateraler Halbleiterkondensator ausgestaltet sein.

Die erste dünne Zwischenschicht ist eine Diffusionsbarriere, die verhindert, dass in auf das Abscheiden der Praseodymoxid enthaltenden Schicht folgenden thermischen Prozessschritten Sauerstoff die Siliziumoberfläche erreicht und diese oxidiert. Dadurch lässt sich verhindern, dass der  $\text{SiO}_2$ -Anteil des  $(\text{PrO}_2)_x(\text{SiO}_2)_{1-x}$ -Mischoxids infolge der Reaktion des Siliziums mit Sauerstoff unkontrolliert wächst und sich die Dielektrizitätszahl des Kondensatordielektrikums verschlechtert. Daneben kann die dünne Zwischenschicht auch als eine Abschirmung des Substratmaterials gegen äußere Einflüsse fungieren.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung, umfasst die erste dünne Zwischenschicht Siliziumoxynitrid (kann in verschiedenen stöchiometrischen Verhältnissen vorkommen, z.B. SiON), im Folgenden kurz Oxynitrid genannt, als Material zum Hemmen der Sauerstoffdiffusion. Die dünne Oxynitrid umfassende Zwischenschicht ermöglicht neben dem Hemmen der Sauerstoffdiffusion die strukturelle und elektronische Anpassung des Praseodymoxids an die Silizium umfassende Halbleiterschicht und kann daher als eine Anpassungsschicht angesehen werden. Sie verringert die Trappdichte, also die Dichte an elektrischen Zustandsniveaus in der Bandlücke des Halbleitermaterials, die freie Elektronen einfangen und so unerwünschte Ladungszustände erzeugen können. Außerdem behindert die Oxynitrid umfassende Zwischenschicht das heteroepitaktische Wachstum (epitaktisches Wachstum eines Materials auf einem aus einem anderen Material bestehenden Substrat) von Praseodymoxid auf dem Silizium umfassenden Halbleitermaterial nicht, so dass einkristallines Wachstum des Praseodymoxids möglich ist.

Vorzugsweise beträgt die Dicke der ersten dünnen Zwischenschicht 0,5 nm oder weniger. Je dünner die erste dünne Zwischenschicht ist, desto weniger beeinflusst sie als Teil des Kondensatordielektrikums die elektrischen Eigenschaften des Kondensators. Die Dicke der ersten dünnen Zwischenschicht kann so weit verringert werden, wie es die Herstellungsprozesse erlauben, solange ihre Wirkung als diffusionshemmende Schicht nicht darunter leidet.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die zweite Kondensatorelektrode aus einer zweiten Halbleiterschicht gebildet. Zwischen der zweiten Halbleiterschicht und dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum ist außerdem eine zweite dünne Zwischenschicht vorhanden. Mittels der zweiten dünnen Zwischenschicht können unkontrollierte chemische Reaktionen zwischen dem Kondensatordielektrikum und der zweiten Halbleiterschicht vermieden werden.

Insbesondere, wenn die zweite Halbleiterschicht Silizium umfasst, ist es vorteilhaft, wenn die zweite dünne Zwischenschicht Oxynitrid oder Silizium-

oxid umfasst, um die Sauerstoffdiffusion oder chemische Reaktionen zu hemmen.. Mit Siliziumoxid als dünner zweiter Zwischenschicht ist es außerdem möglich, beim Aufbringen von polykristallinem Silizium (Polysilizium) als zweiter Halbleiterschicht, z. B. als Gateelektrode eines MOSFETs, das Kondensatordielektrikum in traditioneller Weise, d. h. so wie bei einem Kondensatordielektrikum aus Siliziumoxid, zu kontaktieren. Auch die Dicke der zweiten dünnen Zwischenschicht beträgt wie die der ersten dünnen Zwischenschicht vorzugsweise 0,5 nm oder weniger.

Vorteilhafterweise weist das Oxynitrid der dünnen Zwischenschichten ein Konzentrationsverhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff (O/N-Konzentrationsverhältnis) von 1:1 auf.

Erfindungsgemäße Halbleiterkondensatoren können insbesondere vorteilhaft in Speicherzellen für dynamische Direktzugriffsspeicher (DRAM) oder als Gatekapazität in Feldeffekttransistoren Verwendung finden.

Erfindungsgemäß wird auch ein Verfahren zum Herstellen einer dünnen Oxynitridschicht auf einem Halbleitermaterial angegeben, in dem zuerst eine sehr dünne Siliziumoxidschicht auf das Halbleitermaterial aufgebracht wird, die anschließend zum Nitrieren in einer Stickstoffatmosphäre ( $N_2$ -Atmosphäre) bei 800°C getempert wird.

Daneben wird auch ein Verfahren zum Herstellen einer dünnen Oxynitridschicht auf Silizium angegeben; in dem die Siliziumoberfläche bei 800°C einer Stickstoffmonoxidatmosphäre (NO-Atmosphäre) oder einer Lachgasatmosphäre ( $N_2O$ -Atmosphäre) ausgesetzt wird.

Mit den erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich in vorteilhafter Weise dünne Oxynitridschichten für erfindungsgemäße Halbleiterkondensatoren herstellen. Insbesondere ist mit den erfindungsgemäßen Verfahren das Herstellen von Oxynitridschichten mit so geringen Dicken wie 0,2 nm und einem O/N-Konzentrationsverhältnis von 1:1 möglich.

Nachfolgend werden die bisher beschriebenen sowie weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung anhand und von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ausschnittsweise ein erstes Ausführungsbeispiel für den erfindungsgemäßen Halbleiterkondensator.

Fig. 2 zeigt ausschnittsweise ein zweites Ausführungsbeispiel für den erfindungsgemäßen Halbleiterkondensator.

In Fig. 1 ist ausschnittsweise die Schichtfolge eines erfindungsgemäßen Halbleiterkondensators am Beispiel der Gate-Kapazität eines MOSFETs dargestellt.

Die in Fig. 1 ausschnittsweise dargestellte Gate-Kapazität eines MOSFETs umfasst einen von einem Siliziumsubstrat 1 gebildeten Kanalbereich, der die erste Kondensatorelektrode bildet, und eine Polysilizium-Gateelektrode 3, die die zweite Kondensatorelektrode bildet. Zwischen dem Siliziumsubstrat 1 und der Polysilizium-Gateelektrode 3 befindet sich ein Gatedielektrikum 5 aus Praseodymoxid ( $\text{Pr}_2\text{O}_3$ ) als Kondensatordielektrikum. An der dem Substrat 1 zugewandten Grenzfläche des Gatedielektrikums 5 ist eine aus dem Herstellungsprozess herrührende Mischoxidschicht der Form  $(\text{PrO}_2)_x(\text{SiO}_2)_{1-x}$ , wobei  $x$  Werte im Bereich größer null und kleiner eins annehmen kann, vorhanden. Zwischen dem Mischoxid 7 und dem Siliziumsubstrat 1 befindet sich außerdem eine dünne Oxynitridschicht 9, die als Diffusionsbarriere für Sauerstoff dient und verhindert, dass Sauerstoff während Temperaturschritten, die auf das Abscheiden der Praseodymoxidschicht 5 auf das Siliziumsubstrat 1 folgen, durch das Praseodymoxid 5 hindurch die Siliziumoberfläche des Substrats 1 erreicht und diese oxidiert. Die Oxynitridschicht 9 wird im Herstellungsprozess vor dem Abscheiden der Praseodymoxidschicht 5 geschaffen.

Durch die erfindungsgemäße diffusionshemmende Oxynitridschicht 9 lässt sich die Sauerstoffdiffusion zur Oberfläche des Siliziumsubstrats 1 weitgehend verhindern und so ein unkontrolliertes Wachsen des Mischoxids 7



unterdrücken. Daher lässt sich die Dicke der Mischoxidschicht 7 im Vergleich zum Stand der Technik verringern. Gleichzeitig verringert die dünne Oxynitridschicht 9 die Trappdichte, also die Dichte an elektrischen Zustandsniveaus in der Bandlücke des Halbleitersmaterials, die freie Elektronen einfangen und so unerwünschte Ladungszustände erzeugen können.

Statt einer Oxynitridschicht 9 kann auch eine Schicht aus einem anderen Material verwendet werden, solange dieses Material die Diffusion des Sauerstoffs hemmt und vorzugsweise auch das heteroepitaktische Wachstum des Praseodymoxids auf dem Substrat nicht beeinträchtigt.

Eine dünne Oxynitridschicht auf Silizium kann beispielsweise realisiert werden, indem zuerst eine sehr dünne Siliziumoxidschicht auf das Siliziumsubstrat abgeschieden wird und die abgeschiedene Siliziumoxidschicht dann in einer Stickstoffatmosphäre bei 800°C getempert wird. Bei diesem Tempervorgang wird die dünne Siliziumoxidschicht nitriert. Alternativ kann die dünne Oxynitridschicht auf Silizium realisiert werden, indem die Siliziumoberfläche des Substrats bei 800°C einer NO- oder N<sub>2</sub>O-Atmosphäre ausgesetzt wird. Mit beiden Verfahren sind Oxynitridschichten mit einer Schichtdicke von 0,2 nm und einem O/N-Konzentrationsverhältnis von 1:1 realisierbar.

Ein zweites Ausführungsbeispiel ist in Fig. 2 dargestellt. Vom ersten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich das zweite Ausführungsbeispiel lediglich dadurch, dass zwischen dem Gatedielektrum 5 und der Polysilizium-Gateelektrode 3 eine Siliziumoxidschicht 11 als dünne Zwischenschicht angeordnet ist. Vorzugsweise ist diese Siliziumoxidschicht 11 eine dünne SiO<sub>2</sub>-Schicht mit einer Dicke von 0,5 nm oder weniger. Insbesondere kann die Dicke auch weniger als 0,3 nm betragen. Die Siliziumoxidschicht 11 dient als Interfaceschicht, die sowohl die traditionelle Kontaktierung, d. h. die Kontaktierung wie bei einem aus Siliziumoxid bestehenden Gatedielektrum, ermöglicht, als auch chemische Reaktionen zwischen dem Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Gatedielektrum und dem Polysilizium der Gateelektrode während auf das Abscheiden der Polysilizium-Gateelektrode 3 folgender thermischer Prozessschritte unterbindet.

Statt einer Siliziumoxidschicht als dünner Zwischenschicht 11 kann zwischen der Polysilizium-Gateelektrode 3 und dem Gatedielektrikum 5 auch eine dünne Oxynitridschicht vorgesehen sein. Auch ihre Dicke beträgt vorzugsweise 0,5 nm oder weniger und insbesondere weniger als 0,3 nm. Die mit der Oxynitridschicht als dünner Zwischenschicht 11 erzielten Wirkungen sind ähnlich, wie diejenigen, die mit der Siliziumoxidschicht erzielbar sind. So kann sowohl Oxynitrid als auch Siliziumoxid nach dem Herstellen der Praseodymoxidschicht als Schutzschicht für das Praseodymoxid sowie als Kontaktierungshilfe beim Kontaktieren der Gateelektrode dienen.

In den bisher dargestellten Ausführungsbeispielen besteht die Gateelektrode 3 aus Polysilizium. Es ist jedoch auch möglich, die Gateelektrode 3 aus einem anderen Material, beispielsweise amorphem Silizium oder polykristallinem oder amorphem Siliziumgermanium (SiGe), herzustellen. Die Gateelektrode kann zum unterdrücken von Dotierstoffdiffusion Kohlenstoff oder Sauerstoff enthalten. Daneben sind auch Gateelektroden aus anderen üblichen Materialien, beispielsweise metallische Gateelektroden oder aus Metall-Halbleiter-Verbindungen bestehende Gateelektroden, möglich.

Auch ist das Substrat nicht auf ein Siliziumsubstrat beschränkt. Es können beispielsweise auch ein Siliziumgermaniumsubstrat, ein Siliziumgermaniumsubstrat mit Kohlenstoff oder Sauerstoff als Diffusionshemmer oder ein Siliziumsubstrat mit Kohlenstoff oder Sauerstoff als Diffusionshemmer Verwendung finden. Ebenso braucht das Substrat nicht in einer (001)-Kristallorientierung vorzuliegen.

In einer weiteren Ausführungsform (in den Figuren nicht dargestellt) dient der erfindungsgemäße Halbleiterkondensator als Speicherelement für eine Speicherzelle eines dynamischen Direktzugriffsspeichers (DRAM). Zwischen zwei Kondensatorelektroden aus einem Halbleitermaterial, beispielsweise kristallinem, polykristallinem oder amorphem Silizium oder Siliziumgermanium, jeweils mit oder ohne Kohlenstoff oder Sauerstoff, ist eine Praseodymoxidschicht als Dielektrikum angeordnet. Zwischen dem Praseodymoxid und dem Halbleitermaterial der Kondensatorelektroden befindet sich eine Siliziumoxidschicht oder eine Oxynitridschicht, mit der uner-

wünschte Reaktionen zwischen dem  $\text{Pr}_2\text{O}_3$ -Dielektrikum und dem Halbleitmaterial der Kondensatorelektroden vermieden werden können.

Es sind auch Gestaltungen des Speicherelements möglich, in denen nur zwischen einer der Kondensatorelektroden und der Praseodymoxidschicht eine Zwischenschicht vorhanden ist.

Patentansprüche

1. Halbleiterkondensator mit einer ersten Kondensatorelektrode (1) bildenden, Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht, einer zweiten Kondensatorelektrode (3) und einem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum (5) zwischen den Kondensatorelektroden (1, 3),

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum (5) und mindestens der Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht (1) eine erste dünne Zwischenschicht (9) vorhanden ist, die eine Diffusionsbarriere für Sauerstoff darstellt.

2. Halbleiterkondensator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste dünne Zwischenschicht (9) Oxynitrid umfasst.
3. Halbleiterkondensator nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Dicke der ersten dünnen Zwischenschicht (9) 0,5 nm oder weniger beträgt.
4. Halbleiterkondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die zweite Kondensatorelektrode (3) aus einer zweiten Halbleiterschicht gebildet ist und zwischen der zweiten Halbleiterschicht und dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrikum (5) eine zweite dünne Zwischenschicht (11) vorhanden ist.
5. Halbleiterkondensator nach Anspruch 4, bei dem die zweite dünne Zwischenschicht (11) Oxynitrid umfasst.
6. Halbleiterkondensator nach einem der Ansprüche 4, bei dem die zweite dünne Zwischenschicht (11) Siliziumoxid umfasst.

7. Halbleiterkondensator nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei dem die Dicke der zweiten dünnen Zwischenschicht (11) 0,5 nm oder weniger beträgt.
8. Halbleiterkondensator nach Anspruch 2 oder 5, bei dem das Oxy-  
nitrid der ersten oder der zweiten dünnen Zwischenschicht (9, 11)  
ein Konzentrationsverhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff von 1:1  
aufweist.
9. Speicherzelle für einen dynamischen Direktzugriffsspeicher, die ei-  
nen Halbleiterkondensator nach einem der Ansprüche 1 bis 8 um-  
fasst.
10. Feldeffekttransistor mit einem Substrat (1), einer Gateoxidschicht  
(5) und einer Gateelektrode (3), der einen Halbleiterkondensator  
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 umfasst, wobei das Substrat (1)  
die erste Kondensatorelektrode bildet, die Gateelektrode (3) die  
zweite Kondensatorelektrode bildet und das Gateoxid (5) das Kon-  
densatordielektrikum bildet.

### Zusammenfassung

Gemäß der Erfindung wird ein Halbleiterkondensator mit einer ersten Kondensatorelektrode bildenden Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht, einer zweiten Kondensatorelektrode und einem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrum zwischen den Kondensatorelektroden bereitgestellt, in dem zwischen dem Praseodymoxid umfassenden Kondensatordielektrum und mindestens der Silizium umfassenden ersten Halbleiterschicht eine dünne Zwischenschicht vorhanden ist, die eine Diffusionsbarriere für Sauerstoff darstellt. Insbesondere kann die dünne Zwischenschicht Oxynitrid umfassen.

Figur 1

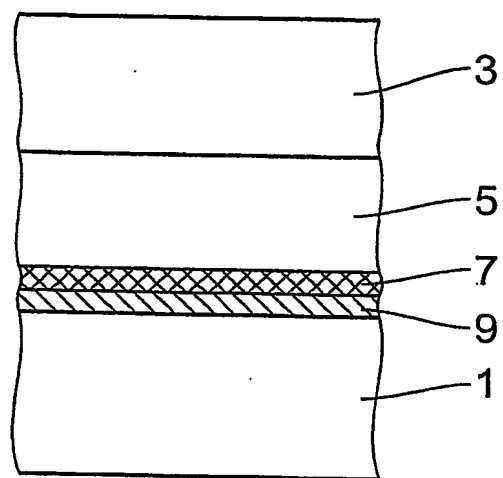


Fig. 1

1/1

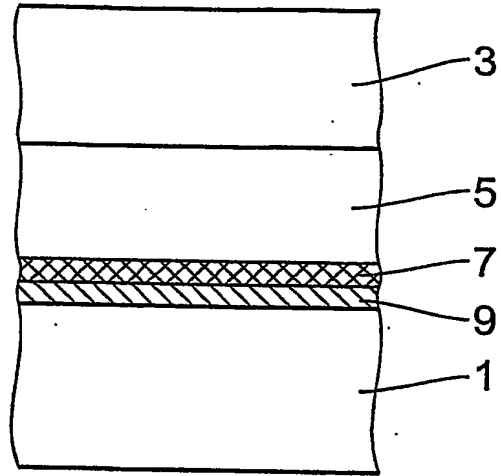


Fig. 1

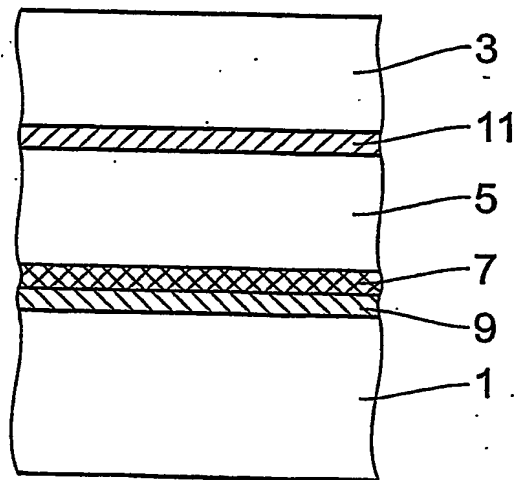


Fig. 2



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**